# GaAs 混频器芯片

### 关键指标

射频&本振频率: 18~28GHz

中频频率: DC~6GHz

本振功率: 17dBm

变频损耗: 9dB

LO/RF 隔离度: 35dB

镜像抑制度: 25dBc

芯片尺寸: 1.4mm×1.1mm×0.1mm

## 产品简介

HG128HA 是一种 I/Q 镜像抑制混频器芯片,集成两个无源双平衡混频器和一个 90°正交电桥, I/Q 两端口输出幅度一致、相位差 90°的中频信号,通过在片外使用一个低频正交耦合器,即可实现镜像抑制功能。

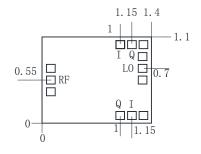
### 电性能 (T<sub>A</sub>=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)		18~28	
IF 频率(GHz)	DC∼6		
变频损耗(dB)	_	9	_
LO~RF 隔离度(dB)	_	35	_
LO~IF 隔离度(dB)	_	20	_
RF∼IF 隔离度(dB)	_	29	_

#### 绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm	
工作温度	-55℃~125℃	
存储温度	-65℃~150℃	

#### 外形和端口尺寸(mm)



#### 注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过 300℃,时间不能超过 30 秒),使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。